

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОППОНЕНТАХ ПО ДИССЕРТАЦИИ САРАЕВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
«ПРИРОДА АВТОКОЛЕБАНИЙ В РЕАКЦИЯХ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ
(МЕТАН, ПРОПАН) НА НИКЕЛЕВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ» НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК**

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения, гражданство	Место основной работы (название организации, ведомство, город, занимаемая должность)	Ученая степень (шифр специальности, по которой присуждена ученая степень в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников)	Ученое звание	Шифр специальности (с указанием отраслей; соответствующего периода; отраслей и сфер деятельности)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Терещенко Олег Евгеньевич	1971г., гражданин РФ	ФГБУН «Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук», г. Новосибирск, старший научный сотрудник	доктор физико-математических наук, 01.04.10 – физика полупроводников, 22.10.2013г.	доцент, 18.11.2005г.	01.04.10 – физика полупроводников

Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет, предшествующих дате защиты Сараева А.А.:

<p>а) Перечень научных публикаций (без дублирования) в изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и Scopus</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. О. Е. Tereshchenko, V. A. Golyashov, S. V. Ereemeev, I. Maurin, A. V. Bakulin, S. E. Kulkova, M. S. Aksenov, V.V. Preobrazhenskii, M. A. Putyato, B. R. Semyagin, D. V. Dmitriev, A. I. Toropov, A. K. Gutakovskii, S. E. Khandarkhaeva, I. P. Prosvirin, A. V. Kalinkin, V. I. Bukhtiyarov, and A. V. Latyshev, Ferromagnetic HfO₂/Si/GaAs interface for spin-polarimetry applications. <i>Appl. Phys. Lett.</i> 107 (2015) 123506. 2. T. Bathon, P. Sessi, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, and M. Bode, Systematics of Molecular Self-Assembled Networks at Topological Insulators Surfaces, <i>Nano Lett.</i>, 2015, 15 (4), pp 2442–2447. 3. T. Bathon, S. Achilli, P. Sessi, V.A. Golyashov, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, and M. Bode, Experimental Realization of a Topological p–n Junction by Intrinsic Defect Grading. // <i>Adv. Mater.</i> doi:10.1002/adma.201504771 (2016). 4. M. S. Aksenov, A. Yu. Kokhanovskii, P. A. Polovodov, S. F. Devyatova, V. A. Golyashov, A. S. Kozhukhov, I. P. Prosvirin, S. E. Khandarkhaeva, A. K. Gutakovskii, N. A. Valisheva, and O. E. Tereshchenko, InAs-based metal-oxide-semiconductor structure formation in low-energy Townsend discharge. <i>Appl. Phys. Lett.</i> 107 (2015) 173501.
--	--

5. P. Sessi, F. Reis, T. Bathon, K.A. Kokh, O.E. Tereshchenko, M. Bode, Signatures of Dirac fermion-mediated magnetic order. *Nature Commun.* 5 (2014) 5349. DOI: 10.1038/ncomms6349.
6. K.A. Kokh, S.V. Makarenko, V.A. Golyashov, O.A. Shegai, O.E. Tereshchenko, Melt growth of bulk Bi₂Te₃ crystals with natural p-n junction. *CrystEngComm.* 16 (2014) 581-584.
7. A.V. Bakulin, S. E. Kulkova, S. V. Eremeev, and O. E. Tereshchenko, Early Stages of Halogen Adsorption on Cation-Rich InAs(001): Surface Etching Mechanism, *The Journal of Physical Chemistry C.* – 2014. – Vol. 118. – p. 10097–10105.
8. X. Li, O.E. Tereshchenko, S. Majee, G. Lampel, Y. Lassailly, D. Paget, J. Peretti, Optical detection of spin-filter effect for electron spin polarimetry, *Appl. Phys. Lett.* 105, 052402 (2014).
9. P. Sessi, T. Bathon, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, and M. Bode, Probing the Electronic Properties of Individual MnPc Molecules Coupled to Topological States. *Nano Lett.*, 2014, 14, 5092–5096. DOI: 10.1021/nl5017893.
10. N.A. Valisheva, M. S. Aksenov, V. A. Golyashov, T. A. Levtsova, A. P. Kovchavtsev, A. K. Gutakovskii, S. E. Khandarkhaeva, A. V. Kalinkin, I. P. Prosvirin, V. I. Bukhtiyarov, and O. E. Tereshchenko, Oxide-free InAs(111)A interface in metal-oxide-semiconductor structure with very low density of states prepared by anodic oxidation. *Appl. Phys. Lett.* 105, 161601 (2014).
11. S. Roy, H.L. Meyerheim, A. Ernst, K. Mohseni, C. Tusche, M. G. Vergniory, T. V. Menshchikova, M. M. Otrokov, A. G. Ryabishchenkova, Z. S. Aliev, M. B. Babanly, K. A. Kokh, O. E. Tereshchenko, E. V. Chulkov, J. Schneider, and J. Kirschner. Tuning the Dirac Point Position in Bi₂Se₃(0001) via Surface Carbon Doping. *Phys. Rev. Lett.* 113,116802 (2014).